Доклады Академии наук СССР 1973. том 208, № 6

УДК 549.321.13:535.37

МИНЕРАЛОГИЯ

п. я. ярош, ф. п. буслаев, л. а. шерстобитова

МИКРОТОПОГРАФИЯ ЦЕНТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В СФАЛЕРИТЕ

(Представлено академиком В. И. Смирновым 30 XII 1971)

До настоящего времени существуют противоречивые данные о локализации центров окраски и люминесценции в объеме кристалла. Одни авторы считают, что указанные центры распределены равномерно в решетке кристалла; другие, наоборот, полагают, что центры расположены на поверхности микроблоков или связаны с трехмерной сеткой дислокаций (1, 2). Эти выводы были сделаны на основании методов оптической микроскопии, не позволяющих наблюдать микротопографию центров окраски и люминесценции. Визуализация этих центров на элементарном уровне была достигнута методом электронно-микроскопического декорирования щелочногалоидных кристаллов. В окрашенных кристаллах NaCl этим методом выявлены как отдельные центры, так и скопления их, и показано, что такие кристаллы состоят из областей различной дефектной структуры и разного знака суммарного заряда (3).

Нами метод электронно-микроскопического декорирования применен для изучения микротопографии центров в кристаллах природного сфалерита. Изучены сфалериты из колчеданных месторождений Урала, Казахстана и Алтая.

Крупные зерна сфалерита раскалывались по спайности на воздухе. На поверхность свежих сколов в вакууме напыляли микронавеску золота и укрепляющий угольный слой по известной методике (4). Пленку отделяли растворением образца в подогретой соляной кислоте. Полученные препараты просматривались в электронном микроскопе УЭМВ-100В.

Обнаружено, что на поверхности сколов кристаллов нелюминесцирующего сфалерита декорирующие частицы золота расположены в основном равномерно, а величина частиц примерно одинакова (рис. 1a) (рис. 1, см. вкл. к стр. 1439).

На поверхности сколов люминесцирующего сфалерита распределение декорирующих частиц весьма неравномерное. На общем фоне равномерно расположенных частиц встречаются участки, полностью лишенные декорирующих частиц,— «мертвые зоны» или же участки, покрытые частицами с большой плотностью. Форма таких зон чаще всего круглая со средним радиусом около $0.5~\mu$ (рис. $16,~\epsilon$). Границы зон четкие, величина частиц в них выше фона.

Образцы люминесцирующих сфалеритов подверглись термообработке. Отжиг кристаллов проводился при температуре 500° в течение 3 час. с последующим охлаждением в воде при температуре 0°. После термообработки сфалерит не люминесцировал. Полученные с этих образцов картины декорирования значительно отличались от картин исходного образца. Исчезли мелкие зоны радиусом менее 0,2 µ. Значительно уменьшилось количество более крупных зон.

Экспериментально показано, что точечные дефекты и их скопления, находящиеся в объеме кристалла, являются электрически активными центрами, на которых происходит кристаллизация декорирующего вещества. По расположению, количеству и величине декорирующих частиц на по-

верхности скола кристалла можно судить о распределении плотности и электрической структуре точечных дефектов и их скоплений в объеме кристалла (5). Таким образом, равномерное распределение декорирующих частиц на поверхности сколов нелюминесцирующего сфалерита свидетельствует об отсутствии скоплений дефектов, об одпородности кристаллов. В противоположность этому, наличие «мертвых зон» и зон с повышенной плотностью частиц на поверхности сколов люминесцирующих кристаллов говорит о существовании скоплений точечных дефектов в их объеме.

Как было показано В. П. Власовым и др. (6), золото на начальных стадиях осаждения кристаллизуется преимущественно на отрицательно заряженных активных центрах. Следовательно, зоны с повышенной плотностью декорирующих частиц можно считать отрицательно заряженными, а «мертвые зоны» — положительно заряженными участками поверхности скола. Весь кристалл является неоднородным, содержащим области разной дефектной структуры и разпого знака суммарного заряда. Большая плотность декорирующих частиц или их полное отсутствие в зонах свидетельствует о большой плотности активных центров, а значит и о большой плотности дефектов в их скоплениях, что приводит к сильному обменному взаимодействию и образованию новой микрофазы. Наличие четких границ зон объясняется скачком потенциала на границе двух фаз.

По вышеописанной методике для контроля были изучены два образца синтетического сфалерита — люминесцирующий и нелюминесцирующий. Полученные картины декорирования оказались полностью тождественны

картинам соответствующего природного сфалерита (рис. 12).

Таким образом, обилие скоплений дефектов в люминесцирующих сфалеритах и их отсутствие в нелюминесцирующих свидетельствуют о том, что такого рода дефекты кристаллической решетки, по всей вероятности, ответственны за люминесценцию. Это подтверждается и результатами термообработки: скопления дефектов не стабильны и распадаются с исчезновением люминесценции.

Одной из наиболее вероятных причин агрегации дефектов в природных кристаллах сфалерита является естественное радиационное облучение минерала, источник которого находится в нем самом. Люминесцирующий сфалерит отличается от нелюминесцирующего относительно повышенной радиоактивностью (7). Установлено, что эта радиоактивность обусловлена наличием субмикроскопической примеси урана. Аналогичное явление агрегации цептров окраски наблюдалось при реакторном облучении щелочногалоидных кристаллов (8). Как и в нашем случае, скопления дефектов в таких кристаллах термически не стабильны.

Институт геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого Уральского научного центра Академии наук СССР Свердловск Поступило 27 XII 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Ф. Д. Клемент, Изв. АН СССР, сер. физ., 39, 86 (1965). ² А. А. Эланго, Р. И. Гиндина, Кристаллография, 9, 712 (1964). ³ Методы электронной микросконии минералов, «Наука», 1969, стр. 157. ⁴ Г. И. Дистлер, В. Н. Лебедева, В. В. Москвин, Кристаллография, 14, 664 (1969). ⁵ Г. И. Дистлер, Изв. АН СССР, сер. физ., 32, 1044 (1968). ⁵ В. П. Власов, Ю. М. Герасимов, Г. И. Дистлер, Кристаллография, 15, 2, 348 (1970). ⁷ П. Я. Ярош, Ю. Ф. Юрин, Зап. Всесоюзн. Мин. общ. сер. 2, 95, в. 6, 748 (1966). ⁸ К. К. Шварц, Ю. А. Экманис, ФТТ, 15, 2, 348 (1970).